# x16 256Mbit HYPERRAM™ 擬似スタティック ランダム アクセス メモリ

HYPERRAM™は、スクラッチパッドやバッファリング目的で拡張メモリを必要とする高性能組み込みシステム向けの高速、低ピン数、低消費電力のセルフリフレッシュ型ダイナミックRAM (DRAM) です。

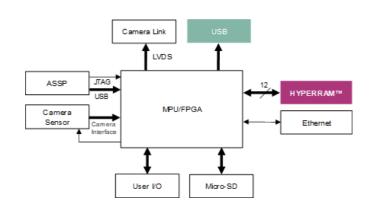
HYPERRAM™ 3.0は、HYPERBUS™インターフェイスの拡張版をサポートしています。16ビットI/Oによって実現されるHYPERRAM™ 3.0は、DDRモードで最大800MBpsの読み取り/書き込み帯域幅を提供します。9Ball BGAパッケージで、拡張動作温度範囲 (-40°C~+105°C) を提供します。現在、インダストリーおよび拡張インダストリー温度グレードが提供可能です。これらの製品は1.8Vのオプションに対応しています。



### 主な特長

- > 動作電圧範囲: 1.7 V ~ 2.0 V
- > HYPERBUS™ 拡張I/O (16ビット)
- > アクセス時間: 35 ns (max), クロックレート: 200 MHz
- > Double data rate (DDR) リード/ライト帯域幅: 800 MBps
- > 設定可能なバーストモード (リニアバースト、ラップレングスバースト、ハイブリッドバースト)
- > 出力駆動強度の設定可能
- > ディープパワーダウン: 12μA (max)、 ハイブリッド ディープスリープ: 140 μA @85° C
- > メモリアレイの分割リフレッシュ機能により、バッテリー性能を最適化
- > パッケージ: 49-ball BGA 8 mm x 8 mm
- > 容量: 256 Mb

## ブロック図



# 製品概要およびユーザーマニュアルへのリンク

| 発注可能な部品番号         | パッケージ   |
|-------------------|---------|
| S80KS2564GACHI040 | 49-FBGA |
| S80KS2564GACHV040 | 49-FBGA |

### 主な利点

- > 高性能 既存のハイパーラム™デバイスのスループットを2倍 の800MBpsに向上
- > 小型パッケージの採用により、基板実装面積を削減
- > 低消費電力 バッテリー駆動のアプリケーションに最適

#### 対象アプリケーション

- > マシンビジョン
- > ファクトリー オートメーション

#### 競合製品に対する優位性

> 高スループット - 800MBPS

### 製品関連情報/オンライン サポート

製品ページ S80KS2564GACHI040製品ページ S80KS2564GACHV040プロダクト ブリーフ製品セレクションガイドアプリケーションノート